СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ *d*-СИММЕТРИИ КАК СЛЕДСТВИЕ КОРРЕЛЯЦИЙ ТИПА ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ

А. А. Овчинников*, М. Я. Овчинникова[†], Е. А. Плеханов

Институт химической физики Российской академии наук 117977, Москва, Россия

Поступила в редакцию 24 декабря 1997 г.

Показана возможность сверхпроводящего порядка d-симметрии, обязанного корреляциям типа валентных связей. Корреляции валентных связей совместимы с антиферромагнитным спиновым порядком. Для явного построения однородного состояния со структурой валентных связей для двумерной модели Хаббарда при произвольном допировании использован вариационный метод унитарных локальных преобразований. Притяжение дырок в d-канале обязано модуляции прыжков заселенностями центров при образовании валентных связей, и параметры его определены вариационно. Важное значение для величины щели имеет увеличение плотности состояний на границе Ферми при антиферромагнитном расщеплении зоны. Величина щели и отношение ее к Т_с имеют порядок $2\Delta \simeq 0.1t$ и $2\Delta/kT_c \simeq 4.5 \div 4$ при $U/t \simeq 8$. Обсуждается соответствие найденной фазовой диаграммы эксперименту. Зависимость T_c от допирования $\delta = |n-1|$ и форма поверхности Ферми очень чувствительны к малому взаимодействию t' диагональных прыжков. При t' > 0 и дырочном допировании максимуму T_c на кривой $T_c(\delta)$ отвечает уровень допирования δ_{opt} , при котором энергия наиболее плоских участков нижней хаббардовской зоны при $k \sim (\pi, 0)$ пересекает уровень Ферми. В недодопированных образцах, $\delta < \delta_{opt}$, анизотропная псевдощель нормального состояния отвечает энергии $|E(\pi, 0) - \mu|$ смещения этой области спектра относительно уровня Ферми.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы методы высокого разрешения в фотоэмиссионной спектроскопии (ARPES) [1,2], в нейтронном рассеянии [3] и в фазовочувствительных экспериментах [4,5] сильно обогатили знание электронной структуры ВТСП. Самые последние результаты относятся к открытию «малой» поверхности Ферми [6] и анизотропной псевдощели в спектре возбуждений в нормальном состоянии «недодопированных» (underdoped) ВТСП [7,8]. Зонный подход, служащий естественным языком для обсуждения этих экспериментов, должен включать в себя обязательный учет всех типов корреляций, роль которых ожидается существенной из рассмотрений в локализованном пределе $U \rightarrow \infty$ или из численных расчетов конечных кластеров.

Во всех теоретических работах ведется поиск ответов на важнейшие вопросы — о возможной корреляционной природе притяжения и механизме спаривания, о роли антиферромагнитных корреляций и корреляций типа образования валентных связей (см. обзоры [9–12]). Идея корреляционной природы сверхпроводящего спаривания отстаивалась и обосновывалась в работах [13].

^{*}E-mail: ovchin@glas.apc.org.

[†]E-mail: movchin@center.chph.ras.ru

Цель данной работы — исследовать эти же вопросы на основе вариационного подхода и явного представления коррелированного состояния. Мы надеемся выявить роль отдельных типов корреляций, в частности, корреляций типа валентных связей. Рассмотрение ведется на классической базовой модели сильно коррелированных систем двумерной модели Хаббарда:

$$H = -t \sum_{\langle nm \rangle, \sigma} (c^{\dagger}_{n\sigma} c_{m\sigma} + \text{H.c.}) + \sum_{n} U n_{n\uparrow} n_{n\downarrow}.$$
(1)

Ее соответствие электронной структуре CuO₂-плоскости и основные параметры достаточно надежно установлены [14, 15].

Впервые введенные Андерсоном [16, 17] состояния резонирующих валентных связей (RVB) означали, что конфигурации системы состоят из синглетных компонент двух частиц, локализованных на узлах, образующих связь. Позже [18-20] для модели Хаббарда были построены вариационные функции — зонные аналоги состояний с периодической димерной структурой и однородные состояния валентных связей [20]. В этих решениях, в отличие от RVB, синглетные пары сопровождаются изменением зарядового состояния узлов, образующих связь. Были исследованы также и некоторые свойства таких состояний (совместимость с антиферромагнетизмом, спектр дырочных возбуждений и его проявления в фотоэмиссионных спектрах и др.). Вне рассмотрения остались вопросы о сверхпроводящем порядке. Между тем предложенный в [19, 20] метод унитарных локальных преобразований, в отличие от неунитарных преобразований типа анзаца Гутцвиллера [21], позволяет построить не только коррелированную функцию, но и явное выражение для эффективного гамильтониана, а следовательно, изучить возможность сверхпроводящего порядка $d_{x^2-y^2}$ -симметрии. Именно такую симметрию можно считать доказанной для ряда купратов (YBa₂Cu₃O_{7- δ}, Bi₂Sr₂CaCu₂O_{8+ δ}) на основе многих экспериментов в разных методиках [10]. Поэтому, а также в силу того что одноцентровое отталкивание подавляет сверхпроводящий порядок з-симметрии, но не влияет на корреляции d-симметрии, мы будем рассматривать лишь последние.

Происхождение притяжения дырок часто связывается со взаимодействием типа коррелированных (или модулированных) прыжков, впервые отмеченным в [22]. В отличие от [22] или аналогичных взаимодействий в t - J-модели [12] в данной работе вид и величина такого рода взаимодействий определяются из вариационного принципа решением соответствующей самосогласованной задачи.

2. ПОСТРОЕНИЕ ОДНОРОДНОГО СОСТОЯНИЯ ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ И САМОСОГЛАСОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Волновая функция Ψ с корреляциями типа валентных связей строится из некоррелированного состояния Φ с помощью унитарного преобразования:

$$\Psi = \hat{W}(\alpha)\Phi, \quad \hat{W}(\alpha) = \exp(\alpha Z), \quad Z = \sum_{(nm)} Z_{nm}.$$
 (2)

Локальный антиэрмитов оператор Z_{nm} , относящийся к связи $\langle nm \rangle$ соседних узлов, равен

$$Z_{nm} = [g_{nm,\sigma}^{\dagger}g_{nm,-\sigma}^{\dagger}u_{nm,-\sigma}u_{nm,\sigma} - \text{H.c.}] \equiv -\frac{1}{2}\sum_{\sigma}j_{nm\sigma}\Delta_{nm,-\sigma}, \qquad (3)$$

$$j_{nm\sigma} = c_{n\sigma}^{\dagger} c_{m\sigma} - c_{m\sigma}^{\dagger} c_{n\sigma}, \qquad \Delta_{nm,-\sigma} = n_{n-\sigma} - n_{m-\sigma}, \tag{4}$$

$$g_{nm,\sigma}(u_{nm,\sigma})=rac{c_{n\sigma}\pm c_{m\sigma}}{\sqrt{2}}.$$

Здесь g и u отвечают четной и нечетной комбинациям орбит соседних центров. Оператор Z_{nm} действует только на синглетные компоненты с двумя частицами на соседних узлах в полной волновой функции Ф. В Ф встречаются разные конфигурации синглетных пар соседних узлов, подобно тому как это встречается в методе RVB [16]. Но в отличие от RVB в нашем случае синглетные пары сопровождаются изменением (оптимизацией) зарядового состояния узлов, образующих связь. Надежды на эффективность преобразования (2) связаны с тем, что в случае только двух узлов с двумя дырками на них волновая функция $\Psi(nm) = \exp(\alpha Z_{nm})\Phi$, построенная из некоррелированной $\Psi = |g_{\uparrow}^{\dagger}g_{\downarrow}^{\dagger}\rangle$ (для t < 0), является точной синглетной функцией системы при оптимальном $\alpha = -0.5 \operatorname{arctg}(U/4t)$.

В силу унитарности преобразования в (2) исходный гамильтониан Хаббарда в базисе коррелированных состояний Ψ строго эквивалентен преобразованному гамильтониану

$$\tilde{H}(\alpha) = W^{\dagger}(\alpha)HW(\alpha) \tag{5}$$

в базисе функций Ф. Вариационный параметр α в $W(\alpha)$ является, по-существу, параметром порядка структур валентных связей. При этом рассмотрение новой проблемы (5) методом среднего поля позволяет исследовать состояния с корреляциями такого типа при произвольном допировании.

В отличие от рассмотренных ранее периодических структур валентных связей с неперекрывающимися димерами [19], в случае однородного состояния (2) локальные операторы Z_{nm} не коммутируют между собой. Поэтому мы не можем найти эффективный гамильтониан во всех порядках по α . Однако мы можем найти явное выражение $\tilde{H}(\alpha)$ через ферми-операторы с точностью до членов ~ α^2 включительно:

$$\tilde{H}(\alpha) \approx H + \alpha[H, Z] + \frac{\alpha^2}{2}[[H, Z], Z] = H^{(0)} + \alpha H^{(1)} + \frac{\alpha^2}{2}H^{(2)}$$
(6)

и найти самосогласованное решение новой проблемы методом среднего поля. В отличие от одиночного димера в 2D-решетке каждый узел завязан на 4 связи. Поэтому, как будет видно дальше, оптимальный параметр преобразования α оказывается малым вплоть до больших U/t ($\alpha \leq 0.22$ при $U/t \leq 8$), что позволяет использовать разложение (6). Помимо малости α еще одно обстоятельство делает исследование гамильтониана (6) второго порядка по α осмысленным. А именно: величина оптимального α зависит, в основном, от U/t и относительно мало меняется при допировании. Это означает, что при фиксированном α на гамильтониан (6) можно взглянуть как на исходный, если угодно, эмпирический эффективный гамильтониан новой модели, изучение которой может приблизить к пониманию реальной ситуации. Полное выражение для $\tilde{H}(\alpha)$ достаточно громоздко.

Разберем подробнее вклад $H^{(1)}$ первого порядка по α в эффективный гамильтониан (6). Выражение его через ферми-операторы имеет вид

$$H^{(1)} = [H, Z] = H_U^{(1)} + T^{(1)},$$
(7)

$$H_U^{(1)} = -\frac{U}{2} \sum_{\langle nm \rangle, \sigma} t_{nm\sigma} \Delta_{nm, -\sigma}^2, \tag{8}$$

$$T^{(1)} = t \sum_{\langle nm \rangle, \sigma} \left\{ \left[\Delta_{nm\sigma} \Delta_{nm, -\sigma} + j_{nm\sigma} j_{nm, -\sigma} \right] + \sum_{m_i \in \langle mm_i \rangle} A(n, m, m_i, \sigma) + \sum_{n_i \in \langle nn_i \rangle} A(m, n, n_i, \sigma) \right\}.$$
(9)

В двух последних трехузельных членах соответственно $m_i \neq n$ и $n_i \neq m$. Операторы $j_{nm\sigma}$, $\Delta_{nm\sigma}$ определены в (4), а операторы A и $t_{nm\sigma}$ определяются выражениями

$$A(n,m,m_i,\sigma) = -\frac{1}{2} [t_{nm_i\sigma} \Delta_{mm_i-\sigma} + j_{nm\sigma} j_{nm_i-\sigma}], \qquad (10)$$

$$t_{nm\sigma} = (c_{n\sigma}^{\dagger} c_{m\sigma} + \text{H.c.}).$$
(11)

Второй порядок по α в гамильтониане (6) содержит двух-, трех- и четырехцентровые вклады. Его выражение полностью приведено в Приложении, формулы (32)–(40).

Исследуем самый общий класс некоррелированных состояний типа БКШ с аномальными средними *d*-симметрии и с удвоенной магнитной элементарной ячейкой для тестирования возможности антиферромагнитного спинового порядка и сверхпроводящего порядка $d_{x^2-y^2}$ -типа. Для функции Ф такого общего вида и эффективного гамильтониана (5) средняя энергия $\overline{H}(y_i) = \langle \Psi H \Psi \rangle = \langle \Phi \tilde{H} \Phi \rangle$ вычисляется точно. Она оказывается функцией от следующих одноэлектронных нормальных и аномальных средних по Ф:

$$\{y_i\} = \{r_0, r_1, r_{\sqrt{2}}, r_2, r_{\sqrt{5}}, r_3, d_0, d_{\sqrt{2}}, d_2, w_1, w_2, w_{\sqrt{5}}, w_3\}_i$$
(12)

где

$$r_{l} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \langle c_{n\sigma}^{\dagger} c_{n+l,\sigma} \rangle, \qquad (13)$$

$$d_l = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \frac{\sigma}{|\sigma|} (-1)^n \langle c_{n\sigma}^{\dagger} c_{n+l,\sigma} \rangle, \qquad (14)$$

$$w_l = \frac{1}{2} \sum_{\sigma} \frac{\sigma}{|\sigma|} \operatorname{sign} \left(l_x^2 - l_y^2 \right) \langle c_{n\sigma}^{\dagger} c_{n+l,-\sigma}^{\dagger} \rangle = w_l^*.$$
(15)

Учтем все типы симметрии исследуемого состояния: трансляционную, по отношению к каждой из замен $x \to -x$ или $y \to -y$, эквивалентность четной и нечетной подрешеток при $\sigma \to -\sigma$. Тогда одноэлектронные узельные средние (13)–(15) действительны и величины $r_l, d_l, |w_l|$ зависят только от |l|; $w_l = 0$ при $l_x = \pm l_y$; $d_l = 0$ для нечетных $l_x + l_y$. От направления I зависит только знак w_l согласно (15). Среднее от любого 2n-фермионного оператора по Φ точно выражается через одноэлектронные средние r_l, d_l, w_l .

При вычислении средней энергии мы ограничивались членами не выше второго порядка по аномальным средним w_l в силу естественной малости T_c и сверхпроводящей щели в масштабах ширины зоны $\sim t$ и антиферромагнитной щели $\sim Ud_0$. В результате среднее от энергии по самому общему некоррелированному состоянию с учетом удвоенной магнитной ячейки и аномальных средних *d*-симметрии выражается через одноэлектронные средние (12). В расчете на один узел оно равно

$$\overline{H}(y_i) = \mathcal{H}(r_i, d_i) + \mathcal{H}^{SC}(w_i, r_i, d_i),$$
(16)

$$\mathcal{H}(r_i, d_i) = \left\{ U(r_0^2 - d_0^2) - 8tr_1 \right\} + \alpha \left\{ -8r_1 U[r_0(1 - r_0) + d_0^2 + r_1^2] + 16t[d_0^2 + 2d_0 d_{\sqrt{2}} + d_0 d_2)] \right\} + \frac{1}{2} \alpha^2 \left\{ \mathcal{H}_U^{(2)} + \mathcal{T}^{(2)} \right\},$$
(17)

$$\mathscr{H}^{SC} = \sum_{ij} k_{ij} w_i w_j = -8\alpha U r_1 w_1^2 + \alpha^2 \sum_{ij} k_{ij}^{(2)} w_i w_j.$$
(18)

Здесь явно выписаны только члены нулевого и первого порядка по α . Вклады $\mathscr{H}_{U}^{(2)}$, $\mathscr{T}^{(2)}$ второго порядка по α и полное выражение для \mathscr{H}^{SC} даются соответственно формулами (42), (44) и (45)–(47) Приложения. Все аргументы, от которых зависит \overline{H} , перечислены в (12). Нетрудно проверить, что \overline{H} инвариантно относительно каждой из замен $(r_l \rightarrow \delta_{l,0} - r_l, t \rightarrow -t)$ или $d_l \rightarrow -d_l$ или $w_l \rightarrow -w_l$ в отдельности. Первая из них отвечает e - h-симметрии хаббардовской модели.

Подробней следует сказать о происхождении членов (18) с аномальными средними. Рассмотрим вклад $\alpha H^{(1)}$ первого порядка по α в эффективный гамильтониан (формулы (7)-(9)). Расчет показывает, что в среднем $\alpha T^{(1)}$ от зонной энергии члены с аномальными средними отсутствуют. И это понятно: ни преобразование $W(\alpha)$, ни сверхпроводящий порядок не могут понизить энергию невзаимодействующих частиц. Но среднее $\alpha H_U^{(1)}$ зависит от аномальных параметров порядка. Действительно, в выражении (8) для оператора $H_U^{(1)}$ встречаются члены типа

$$c_{n\sigma}^{\dagger}c_{m\sigma}(n_{n,-\sigma}+n_{m,-\sigma})-2c_{n\sigma}^{\dagger}c_{m\sigma}n_{n,-\sigma}n_{m,-\sigma}.$$
(19)

Это — варианты взаимодействия коррелированных прыжков (correlated hopping interaction), модулируемых заселенностями узлов. Первое слагаемое в (19) имеет вид взаимодействия, предложенного Хиршем [22]. Вклад с аномальными средними от этого оператора равен нулю,

$$\langle c_{n\sigma}^{\dagger} c_{m\sigma} (n_{n,-\sigma} + n_{m,-\sigma}) \rangle = -2w_0 w_{|n-m|}^{(s)},$$

поскольку сверхпроводимость *s*-типа запрещена ($w_0 = \langle c_{n\uparrow}^{\dagger} c_{n\downarrow}^{\dagger} \rangle = 0$). Возникновение сверхпроводящего порядка *s*-симметрии ($w_0 \neq 0$) в искомом состоянии Φ повлекло бы за собой повышение энергии на величину $\Delta \overline{H} = U w_0^2$ на узел. Вклад в энергию от аномальных параметров порядка *d*-симметрии обязан именно операторам типа второго слагаемого в (19). В (18) явно выписан этот определяющий вклад. В действительности в расчете использовалось полное выражение (45)–(47) для вклада в среднюю энергию от аномальных средних.

Наличие в \overline{H} линейного по α члена говорит о том, что минимум $\overline{H}(\alpha)$ отвечает ненулевому значению α . Уже из (16)–(18) следуют относительные знаки ряда величин при t > 0 в (1):

$$tr_1 > 0, \quad r_1 > 0, \quad \alpha r_1 > 0, \quad \alpha > 0, \quad k_{11} \simeq -8\alpha r_1 U < 0.$$
 (20)

Итак, требование снижения энергии в результате образования валентных связей определяет знак параметра преобразования, что влечет за собой отрицательный знак главной константы k_{11} сверхпроводящего порядка *d*-симметрии в (18), а следовательно, возможность существования сверхпроводимости *d*-симметрии.

Однодетерминантная некоррелированная функция Ф, минимизирующая энергию $(\overline{H} - \mu \overline{N})$, является произведением одночастичных (квазичастичных для H) собственных функций $\chi^{\dagger}_{k\lambda\sigma}$ линеаризованного гамильтониана

$$\tilde{H}_L = \sum_{\nu} \frac{\partial \overline{H}}{\partial y_{\nu}} (\hat{y}_{\nu} - y_{\nu}) + \overline{H}(y_i) = \sum_k^F \hat{h}_k + \text{const.}$$
(21)

Операторы \hat{y}_i , отвечающие средним y_i (см. (12)–(15)), равны

$$\hat{r}_{l} = \frac{1}{2n_{l}} \sum_{l,\sigma} c_{n,\sigma}^{\dagger} c_{n+l,\sigma},$$

$$\hat{d}_{l} = \frac{1}{2n_{l}} \sum_{l,\sigma} (-1)^{n} \frac{\sigma}{|\sigma|} c_{n,\sigma}^{\dagger} c_{n+l,\sigma},$$

$$\hat{w}_{l} = \frac{1}{4n_{l}} \sum_{l,\sigma} \operatorname{sign} (l_{x}^{2} - l_{y}^{2}) \frac{\sigma}{|\sigma|} [c_{n,\sigma}^{\dagger} c_{n+l,-\sigma}^{\dagger} + \mathrm{H.c.}].$$
(22)

Здесь n_l число всех векторов l длины l = |l|, по которым ведется суммирование.

В результате в базисе импульсных операторов

$$b_{k,j}^{\dagger} = \{ c_{k\uparrow}^{\dagger}, \ c_{k\downarrow}^{\dagger}, \ c_{-k\downarrow}, \ c_{-\bar{k}\downarrow} \}_{j}, \qquad j = 1, \dots 4, \qquad \tilde{k} = (\pi, \pi) + k,$$
(23)

линеаризованный гамильтониан (21) запишется в виде

$$H_L = \sum_{k}^{F} \hat{h}_k + \text{const}, \qquad \hat{h}_k = \sum_{i,j=1}^{4} L_{ij} b_{ki}^{\dagger} b_{kj}.$$
(24)

Здесь $\tilde{k} = k + (\pi, \pi)$ и индекс F у суммы означают суммирование по k внутри магнитной зоны Бриллюэна $|k_x \pm k_y| < \pi$. Матрица L_{ij} дается формулой

$$L_{ij} = \begin{pmatrix} \epsilon_{k} - \mu & \Delta_{k} & W_{k} & 0 \\ \Delta_{k} & \epsilon_{\bar{k}} - \mu & 0 & W_{\bar{k}} \\ W_{k} & 0 & -(\epsilon_{k} - \mu) & \Delta_{k} \\ 0 & W_{\bar{k}} & \Delta_{k} & -(\epsilon_{\bar{k}} - \mu) \end{pmatrix};$$
(25)

$$\epsilon_{k} = \frac{1}{2} \sum_{l} \frac{\partial \overline{H}}{\partial r_{l}} g_{l}(k), \quad \Delta_{k} = \frac{1}{2} \sum_{l} \frac{\partial \overline{H}}{\partial d_{l}} g_{l}(k), \quad W_{k} = \frac{1}{2} \sum_{l} \frac{\partial \overline{H}}{\partial w_{l}} q_{l}(k).$$
(26)

В суммах по *l* в величинах ϵ_k , Δ_k , W_k индекс *l* перебирает все r_l , либо d_l , либо w_l из полного набора (12) одноэлектронных средних, от которых зависит \overline{H} . В формулах (25), (26) использованы следующие обозначения:

$$g_l(k) = \frac{1}{n_l} \sum_{l} \cos k_x l_x \cos k_y l_y, \quad q_l(k) = \frac{1}{n_l} \sum_{l} \operatorname{sign} \left(l_x^2 - l_y^2 \right) \cos k_x l_x \cos k_y l_y.$$
(27)

Здесь n_l число всех векторов l длины l = |l|, по которым ведется суммирование в (27), а сами функции (27) обладают симметрией:

$$g_l(\tilde{k}) = (-1)^{l_x + l_y} g_l(k), \quad q_l(\tilde{k}) = (-1)^{l_x + l_y} q_l(k).$$

Одноэлектронные собственные функции $\chi_{k\lambda}$ и спектр $\mathscr{C}_{\lambda}(k)$ линеаризованного гамильтониана находятся диагонализацией матрицы (25),

$$\chi_{k\lambda}^{\dagger} = \sum_{j} b_{kj}^{\dagger} S_{j,\lambda}, \qquad \sum_{j} L_{ij} S_{j,\lambda} = S_{i,\lambda} \mathscr{C}_{\lambda}, \tag{28}$$

для каждого k, принадлежащего магнитной зоне Бриллюэна. Знание собственных функций и спектра позволяет замкнуть процедуру самосогласования, т.е. вычислить искомые средние $y_i = \langle \hat{y}_i \rangle_{\Phi}$ по формулам

$$r_{l} = \frac{1}{2N} \sum_{k}^{F} [g_{l}(k)(U_{11} + 1 - U_{33}) + g_{l}(\tilde{k})(U_{22} + 1 - U_{44})],$$

$$d_{l} = \frac{1}{2N} \sum_{k}^{F} g_{l}(k)[U_{12} + U_{21} + U_{34} + U_{43}],$$

$$w_{l} = \frac{1}{2N} \sum_{k}^{F} [q_{l}(k)(U_{13} + U_{31}) + q_{l}(\tilde{k})(U_{24} + U_{42})],$$
(29)

где

$$U_{ij} = \sum_{\lambda} S_{i\lambda}^* S_{j\lambda} f_F(\mathscr{C}_{\lambda}/kT)$$

и $f_F(x)$ — фермиевские функции; g и q определены выражениями (27).

Описанная процедура самосогласования минимизирует энергию по Ф. Последующая минимизация по α дает искомое вариационное коррелированное состояние (2) и оптимальный эффективный гамильтониан (6) в базисе некоррелированных состояний. Проводилось два взаимно согласующихся типа самосогласованных расчетов: полный расчет со всеми нормальными и аномальными средними, дающий сверхпроводящую щель $2\Delta_0(U, \delta, T)$ для состояний валентных связей с антиферромагнитным и сверхпроводящим порядком (AF + VB + SC), и расчет температуры сверхпроводящего перехода $T_c(U, \delta)$ из линейных по w_l уравнений на фоне таких же состояний (AF + VB) без аномальных средних. В последнем случае критическая температура сверхпроводящего перехода вычисляется из стандартных уравнений теории возмущения по нарождающимся аномальным параметрам порядка:

$$\operatorname{Det} |D_{ij} - \delta_{ij}| = 0, \qquad D_{ij} = \partial w_i / \partial w_j|_{w_l = 0}.$$
(30)



Рис. 1. Средние энергии, приходящиеся на один узел решетки, для антиферромагнитного и парамагнитного состояний с корреляциями типа валентных связей (сплошные кривые AF + VB и VB), либо для аналогичных некоррелированных состояний приближения Хартри-Фока (кривые AF и HF соответственно). Штриховая кривая AF + DM отвечает периодической димерной структуре валентных связей. Точки — результат [22] точной диагонализации гамильтониана для кластера 4 × 4

Матрица D_{ij} вычисляется с помощью формул (48), (49) Приложения.

Независимой проверкой (или основой для альтернативной итерационной процедуры) служило соотношение $\alpha = -\overline{H}^{(1)}(y_i)/\overline{H}^{(2)}(y_i)$ между оптимальным параметром α и средними от вкладов в эффективный гамильтониан (6) при самосогласованных значениях y_i . Проверялось и совпадение всех физических величин для одинаковых по величине дырочного и электронного допирований. При наличии антиферромагнитного порядка ($d_0 \neq 0$) результаты с использованием численной диагонализации (28) и приближенного решения для S_{ij} (формула (52) Приложения) совпадают. Это означает, что в сверхпроводящем спаривании участвуют в основном состояния только нижней (или только верхней) хаббардовской зоны при дырочном (электронном) допировании.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследованная нами область $U/t \leq 9$ ограничена требованиями малости оптимального параметра α . Описание CuO₂-плоскости однозонной моделью Хаббарда предполагает $U/t \sim 8$ [14, 15]. В указанной области учет корреляций типа валентных связей действительно понижает энергию системы, причем однородное состояние валентных связей оказывается ниже аналогичного состояния с периодической димерной структурой и при малом допировании каждое из них сосуществует с антиферромагнетизмом.

Масштаб энергетического эффекта виден из рис. 1 для системы с U/t = 8. Точки на рисунке — результат точной диагонализации для кластеров 4 × 4 [23]. В сравнении с энергией парамагнитного состояния простого метода Хартри-Фока основное понижение энергии при $n \rightarrow 1$ возникает от чередования спинов. Область антиферромагнитного порядка на диаграмме взаимодействие — допирование приведена на рис. 2*a*. Критический уровень допирования $\delta_c = |n_c - 1|$, при котором исчезает антиферромагнитный порядок, составляет $\delta_c \sim 0.26 \div 0.3$ для $U/t = 6 \div 8$. Эти значения ниже, чем соответствующий результат $\delta_c \sim 0.4 \div 0.45$ в обобщенном методе Хартри-Фока без учета корреляций типа валентных связей, однако они превышают критическую степень допирования $\delta_c \sim 0.05$, разрушающего антиферромагнетизм в реальных кристаллах ВТСП.



Рнс. 2. а) Фазовая диаграмма для решений с корреляциями VC на плоскости. Сплошная кривая — критическая степень допирования, при которой исчезает антиферромагнетизм. Штриховой линией обозначена граница существования анизотропной сверхпроводящей щели, рассчитанная при температуре kT = 0.002t. Начальная часть кривой (короткие штрихи) приведена схематично ввиду сверхмалых величин щели и плохой сходимости вблизи T_c . б) Зависимость оптимального параметра преобразования α от U/t для недопированной системы (n = 1) и при степени допирования |n - 1| = 0.1 (соответственно сплошная и штриховая кривые)

На диаграмме рис. 2*a* значение $\delta_c \sim 0.05$ отвечало бы слишком малой величине $U/t \le 2$.

Могут быть предложены различные объяснения этого несоответствия.

В простейшей гипотезе большая область антиферромагнетизма считается следствием неучета в исходной модели Хаббарда взаимодействий, нарушающих совершенный нестинг. Между тем наличие прыжкового взаимодействия t' неближайших соседей в купратах следует из разных исследований: из подробностей однозонного отображения [14] трехзонной модели Эмери; из эмпирических моделей сильной связи [24], которые воспроизводят полученную из данных ARPES форму поверхности Ферми и зоны; из моделирования уровней конечных кластеров с помощью t - t' - J-модели и данных LDA расчетов [25]. Эмпирически найденный параметр диагональных прыжков $t'/t \sim 0.2$ [24, 25] превышает теоретические оценки [14] и различен для разных керамик [26]. Следует иметь в виду, что эмпирические оценки основаны на подгонке данных ARPES под единую зону, не расщепленную на нижнюю и верхнюю хаббардовские подзоны. В условиях антиферромагнитного расщепления и плоских зон чувствительность ферми-поверхности и других характеристик к t' возрастает. Поэтому реальные значения t'/t могут оказаться ниже. Наши расчеты, однако, показали, что введение взаимодействия t' почти не сдвигает границу (по допированию) между антиферрромагнитным и парамагнитным состояниями.

Можно думать, что метод среднего поля (в данном случае примененный к эффективному гамильтониану $\tilde{H}(\alpha)$) не способен описать антиферромагнитные корреляции спинов с большой, но конечной длиной корреляции. Между тем в технике слейв-бозонов до перехода к парамагнитному состоянию просматриваются две фазы спинового устройства — с коротким либо с дальним антиферромагнитным спиновым порядком [27, 28]. Причем суммарная граница истинного парамагнитного состояния очень близка к той же границе на рис. 1. Существуют и независимые аргументы, говорящие в пользу гипотезы о большой области антиферромагнитного спинового порядка отдельных CuO₂-плоскостей в отличие от наблюдаемой малой области объемного антиферромагнетизма (см., например, [10, 29]). Наиболее яркие из них — обнаруженное с помощью ARPES [6] превращение поверхности Ферми в малую поверхность Ферми в недодопированной области Bi₂Sr₂CaCu₂O₈₊₆ и наблюдение теневых границ Фер-

8 ЖЭТФ, №3 (9)



Рис. 3

Рис. 4

Рис. 3. Величина главной константы k_{11} сверхпроводящего порядка *d*-симметрии в среднем от эффективного гамильтониана (10), (11) в зависимости от степени допирования для антиферромагнитных либо парамагнитных состояний валентных связей для U/t = 4, 6, 8. Штриховые линии отвечают парамагнитным решениям в области, где низшим по энергии является антиферромагнитное состояние

Рис. 4. Зависимость логарифма критической температуры T_c от степени допирования. Сплошные либо штриховые кривые отвечают антиферромагнитным либо парамагнитным состояниям валентных связей. Кривые 1, 2, 3 соответствуют значениям U/t = 8, 6, 4

ми, центрированных вокруг точки $\Gamma(0,0)$, в сканирующем варианте ARPES [30]. Другие аргументы в пользу широкой области антиферромагнитного порядка CuO₂-плоскостей приводятся в [31] и служат основой самой последней теории сверхпроводимости [32].

В рамках метода среднего поля мы не можем рассчитать ни радиус R_{AF} области, в которой ось квантования антиферромагнитно чередующихся спинов сохраняет свое направление, ни динамику флуктуаций этой оси. Но энергетика процесса (см. рис. 1) заставляет предполагать, что этот размер много больше постоянной решетки $(R_{AF} \gg a)$. Поэтому, с точки зрения короткорадиусных корреляций типа валентных связей и притяжения дырок, индуцируемого образованием валентных связей соседних узлов, мы можем принять гипотезу о реальности «двумерного антиферромагнетизма» CuO₂-плоскостей в широкой области допирования, в отличие от малой области существования объемного антиферромагнетизма в купратах.

Из рис. 26 видны характерные величины оптимального параметра преобразования α . Он зависит в основном от U/t и слабо меняется с изменением n. Из зависимости $\alpha(U)$ следует, что разложением (6) можно пользоваться вплоть до $U/t \leq 8$.

Перейдем к главной цели работы — изучению возможности сверхпроводящего порядка *d*-симметрии. Ввиду быстрого убывания аномальных средних w_l с ростом *l* показательными являются уже знак и величина коэффициента k_{11} в главном вкладе $[k_{11}w_1^2]$ в сверхпроводящую часть (18) средней энергии (16). На рис. 3 представлены зависимости коэффициента k_{11} от допирования для ряда значений U/t для антиферромаг-

нитных или парамагнитных состояний валентных связей. Данные для парамагнитных состояний, сильно невыгодных по энергии, приведены лишь с одной целью: убедиться, что причиной притяжения дырок ($k_{11} < 0$) являются не далекие антиферромагнитные корреляции, а корреляции типа валентных связей. В частности, $k_{11} = 0$ при $\alpha = 0$. Для парамагнитных состояний коэффициент k_{11} также отрицателен и даже больше по абсолютной величине. Тем не менее из-за разницы в плотностях состояний на границе Ферми только в антиферромагнитном состоянии имеется достаточно широкая область допирования, в которой система характеризуется большой сверхпроводящей щелью и высокой температурой перехода T_c .

Критическая температура $T_c(U, \delta)$ сверхпроводящего перехода вычисляется из уравнения (30) как момент появления аномальных средних w_l на фоне нормального состояния AF + VB. Значения T_c совпадают с температурой исчезновения сверхпроводящей щели $2\Delta(T)$ и аномальных средних в полном расчете. На рис. 4 приведены зависимости логарифма $\lg T_c(n)$ от степени допирования для U/t = 8 и 6. Вся область существования сверхпроводимости находится внутри области антиферромагнитного порядка, т.е. ниже границы $\delta_c(U/t)$ между состояниями AF + VB и PM + VB на рис. 2*a*.

В то же время аналогичные зависимости $\lg T_c(n)$ для парамагнитных состояний резко убывают при $T_c \rightarrow 0$ уже при очень малом допировании. Это связано с тем, что плотность одноэлектронных состояний соответствующей эффективной линеаризованной задачи велика лишь в очень узкой области вблизи особенности Ван-Хова при $k = (0, \pm \pi)$, $(\pm \pi, 0)$. Напротив, для антиферромагнитных состояний связанное со спиновым чередованием расщепление исходной зоны на две приводит к значительному расширению области с большой плотностью состояний вблизи $(0, \pi)$ и, как следствие, к расширению области высокой температуры сверхпроводящего перехода (см. плато на кривых рис. 4).

Остается вопрос, который не может быть решен в рамках метода среднего поля: существует ли другой, помимо антиферромагнитного удвоения ячейки, механизм расщепления исходной зоны на верхнюю и нижнюю хаббардовские зоны, который также расширял бы области плоских участков спектра вблизи границы Ферми. По существу, тот же вопрос вставал при обсуждении противоречий между границами исчезновения «двумерного» антиферромагнитного порядка в наших рассчетах и объемного антиферромагнетизма реальных купратов.

Вернемся к свойствам полученного состояния со сверхпроводящим порядком $d_{x^2-y^2}$ -симметрии, обязанным корреляциям типа валентных связей. На рис. 5 представлены зависимости сверхпроводящей щели $2\Delta(T)$ от температуры для ряда параметров модели. Отношение $\xi = 2\Delta(0)/kT_c$ меняется в пределах $4.5 \div 3.9$ для U/t = 8 вместо значения 3.5 в теории БКШ. Найденные значения отношения ξ меньше значений $\xi = 2\Delta(0)/kT_c \sim 10 \div 12$, полученных в приближениях типа самосогласованных методов спектральных функций [33–35] или функций Грина [36]. Наблюдаемое в разных экспериментах отношение ξ сильно анизотропно и зависит от *z*-компоненты квази-импульса, при этом величина, относящаяся к *ab*-плоскости купратов, варьируются в пределах $\xi \sim 5 \div 7$ [29, 37].

Таким образом, согласно расчетам среднего поля для $H(\alpha)$ область сверхпроводимости *d*-симметрии лежит внутри области «двумерного» (или скрытого) антиферромагнитного спинового порядка, найденной в том же приближении. Как уже отмечалось, эта область в нашем подходе в проекции на реальные объекты может отвечать области далеких спиновых корреляций, но не обязательно настоящего дальнего порядка. На



Рыс. 5. Величина сверхпроводящей щели $2\Delta(T)$ как функция температуры для U/t = 8 (сплошные кривые) либо U/t = 6 (штриховые кривые). Кривые 1, 2, 3 соответствуют степеням допирования |n - 1| = 0.1, 0.15, 0.2

рис. 2*а* штриховая линия отвечает границе области сверхпроводимости по допированию при температуре kT = 0.002t. Заметим, что при U/t = 8 максимальная критическая температура равна $kT_c = 0.023t$. Соответствующая ей величина щели равна $2\Delta(0) = 0.107t$, что при оценке $t \sim 0.5$ эВ [14] составляет $2\Delta(0) = 53$ мэВ при $kT_c = 133$ К.

Неожиданный результат расчета — сохранение большой величины анизотропной щели d-симметрии в широкой области допирования вплоть до очень малых значений $\delta = |n - 1| \sim 0.03 \div 0.04$ при $U/t = 6 \div 8$. Для исходной модели Хаббарда переход к диэлектрическому состоянию $T_c = 0$ при $n \to 1$ происходит лишь при сверхмалом допировании, когда химический потенциал приподнимается над краем нижней хаббардовской зоны и величина $\delta = |n - 1|$ определяется хвостом функции рапределения. В области $\delta > 0.05$ величины T_c и 2 Δ (0) остаются постоянными или даже увеличиваются при уменьшении δ . Это противоречит фазовой диаграмме реальных купратов [10], где температура $T_c(\delta)$ резко убывает при уровне допирования меньшем оптимального значения δ_{opt} , отвечающего максимуму T_c .

Можно по-разному интерпретировать указанное противоречие.

Можно пытаться использовать аргументы работ [38, 39]. В них предполагается существование состояний с отличными от нуля аномальными средними и анизотропной щелью, которые из-за квантовых флуктуаций не обладают фазовой когерентностью дальнего порядка и не проявляют сверхпроводящих свойств. Такая гипотеза выдвигалась при попытке согласовать отсутствие сверхпроводимости и наличие анизотропной псевдощели нормального состояния «недодопированных» образцов. Более конструктивным, однако, представляется поиск реальных взаимодействий, подавляющих сверхпроводящий порядок при малом допировании.

Предположим, что причина такого поведения системы связана с идеальностью самой модели (1), с неучетом в исходной модели Хаббарда взаимодействий, нарушающих совершенный нестинг. Например, мы не учитывали прыжкового взаимодействия t' неближайших (диагональных) соседей. Мы не учитывали также подобное кулоновское взаимодействие частиц на разных центрах. Особый интерес к взаимодействию t' связан с несколькими причинами. Во-первых, оно не нарушает совершенный нестинг недопированных систем, но очень сильно влияет на форму поверхности Ферми



Рис. 6

Рис. 7

Рис. 6. Зависимость логарифма критической температуры T_c от степени допирования для расширенной модели Хаббарда (31) с U/t = 8, t' = 0 и различной величиной параметра V взаимодействия частиц соседних центров. Сплошные кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют значениям V/t = 0, 0.1, 0.2, 0.25. Штриховая кривая — расчет для U/t = 10, V/t = 0.2, t' = 0

Рис. 7. Влияние параметра t' на фазовую кривую $T_c(\delta)$ для расширенной модели (31) при U/t = 8, V/t = 0.1. Кривые 1, 2, 3 соответствуют значениям t'/t = 0, 0.05, 0.1, кривые 4, 5 — отрицательным значениям t'/t = -0.05, -0.1

из-за очень плоских зон. Во-вторых, величина и даже знак t' зависят от материала из-за конкуренции двух каналов таких диагональных прыжков в CuO₂-плоскости через прямое взаимодействие t_{pp} кислородных орбит и через процесс второго порядка по p - d-гибридизации. Поэтому сравнительный анализ влияния t' в разных купратах может быть принципиальным [26].

В связи со сказанным мы провели самосогласованные расчеты фазовой диаграммы и некоторых характеристик системы с эффективным гамильтонианом расширенного вида:

$$H_{eff}(\alpha) = \tilde{H}(\alpha, U, t) + V \sum_{\langle nm \rangle} n_n n_m + t' \sum_{\langle \langle nm \rangle \rangle} \sum_{\sigma} (c^{\dagger}_{n\sigma} c_{m\sigma} + \text{H.c.}),$$
(31)

т. е. к прежнему эффективному гамильтониану (6) добавлено подобное кулоновскому взаимодействие ближайших соседних ячеек V и прыжковое взаимодействие t' между соседними диагональными узлами $\langle \langle nm \rangle \rangle$ с $|n - m| = \sqrt{2}$. Простоты ради для качественной оценки эффекта включены лишь нулевые по α порядки каждого из этих взаимодействий.

На рис. 6 представлены зависимости T_c от уровня допирования для $V = 0 \div 0.25t$. Кулоновское взаимодействие соседних центров действительно разрушает сверхпроводящий порядок при малом допировании и одновременно понижает максимальную температуру перехода T_c . В частности, для V = 0.2t, U/t = 8 и |n - 1| = 0.1 величина T_c снижается до значения $T_c = 0.0057t$. При оценке $t \sim 0.5$ эВ [14] это отвечает $T_c \sim 30K$, что ниже средних наблюдаемых значений $T_c^{max} \sim 100K$. Последнее значение отвечало бы скорее $U/t \sim 10$ при V/t = 0.2 (см. штриховую кривую на рис. 6), хотя при таком U параметр преобразования $\alpha \sim 0.27$ уже не мал. Эффект понижения T_c с ростом V понятен. К главной константе сверхпроводящего порядка — к коэффициенту k_{11} при w_1^2 в средней энергии — добавляется постоянное положительное приращение $\Delta k_{11} = 4V$. Исчезновение сверхпроводящего порядка при малом допировании можно связать с уменьшением корреляционного притяжения $k_{11} \approx -8\alpha Ur_1 + 4V$ с уменьшением r_1 в ходе антиферромагнитной локализации дырок при $n \rightarrow 1$.

Рисунок 7 демонстрирует очень сильное влияние взаимодействия t' диагональных прыжков на форму зависимости $T_c(\delta)$. Это влияние различно при разных знаках t'.

При t' > 0 зависимость $T_c(\delta)$ подобна наблюдаемой — с резким убыванием T_c с двух сторон от оптимального уровня допирования δ_{opt} . С ростом t' величина δ_{opt} смещается в сторону больших значений при неизменной максимальной температуре перехода $T_c(\delta_{opt})$. Такое поведение становится понятным, если учесть, что при $t' \neq 0$ энергия $E_1(k)$ нижней хаббардовской зоны вдоль границы $|k_x \pm k_y| = \pi$ магнитной зоны Бриллюэна не постоянна:

$$E_1(k) - E_1(\pi, 0) = 4t'(\cos k_x \cos k_y + 1).$$

Заметим, что хотя граница магнитной зоны Бриллюэна в диэлектрическом недопированном случае — это лишь линия минимальной диэлектрической щели, тем не менее в фотоэмиссионных спектрах ARPES она проявляется как размытая граница Ферми в силу разной интенсивности фотоэмиссии в основной и расширенной зонах Бриллюэна, несмотря на одинаковые зонные энергии при антиферромагнитном удвоении элементарной ячейки.

Знаменательно, что при t' > 0 и дырочном допировании именно при оптимальном уровне допирования (при максимальной T_c) самый плоский участок нижней хаббардовской зоны выходит на поверхность Ферми:

$$E_1(\pi, 0) - \mu = 0$$
 при $\delta = \delta_{opt}, n < 1.$

На рис. 8 представлены зависимости зонной энергии $[E_1(k) - \mu]$ относительно химического потенциала в двух точках $k = (\pi, 0)$ и $k = (\pi/2, \pi/2)$ границы магнитной зоны Бриллюэна. При t' = 0 эти энергии почти совпадают, так что при допировании открывается сразу «большая» поверхность Ферми, центрированная в точке $\Gamma(0,0)$, и соответствующая теневая поверхность Ферми вокруг точки $Y(\pi, \pi)$. При $t' \neq 0$ эволюция границы Ферми при допировании оказывается качественно другой. При t' > 0 имеем

$$E_1(\pi/2,\pi/2) - E_1(\pi,0) \sim 4t' > 0.$$

Значит, при малом допировании, $\delta < \delta_{opt}$, открывается «малая» поверхность Ферми в виде карманов вокруг точки ($\pi/2, \pi/2$), в то время как участки $k \sim (\pi, 0)$ с наибольшей плотностью состояний остаются ниже границы Ферми. Только при оптимальном допировании, $\delta = \delta_{opt}$, происходит пересечение границей Ферми точки (π , 0), после чего поверхность Ферми превращается в «большую». Если учесть, что участки границы магнитной зоны Бриллюэна, т.е. диэлектрические участки, воспринимаются в экспериментах ARPES как размытые границы Ферми, то и при малом допировании эксперимент ARPES может быть интерпретирован в терминах обобщенной «большой»



Рис. 8. Зонная энергия $E(k) - \mu$, отсчитанная от химического потенциала, в двух точках границы магнитной зоны Бриллюэна — при $k = (\pi, 0)$ (сплошные кривые) и при $k = (\pi/2, \pi/2)$ (штриховые кривые) для модели U/t = 8, V/t = 0.1 и различных t'. Кривые 1, 2, 3 соответствуют значениям t'/t = 0, 0.05, 0.1 и фазовым кривым 1, 2, 3 на рис. 7

поверхности Ферми, составленной из диэлектрических участков границы и нетеневых (по интенсивности) металических участков «малой» поверхности Ферми.

В такой картине обнаруженная в последние годы [7,8] псевдощель в нормальном состоянии недодопированных (underdoped) образцов Bi₂Sr₂CaCu₂O_{8+ δ} есть ничто иное, как энергия $|E_1(\pi, 0) - \mu|$, необходимая для выбивания электронов из участков $k \sim (\pi, 0)$ с наибольшей плотностью состояний. В недодопированной области эти участки фазового пространства потоплены ниже уровня Ферми и, следовательно, заселены. В случае $\delta > \delta_{opt}$ (overdoped region) эти участки спектра выше уровня Ферми и не заселены. Более подробные расчеты и сопоставления фотоэмиссионных спектров — предмет отдельного исследования.

Системы с другим знаком взаимодействия, t' < 0, обнаруживают совершенно другое поведение фазовой кривой $T_c(\delta)$ (см. рис. 7) и границы Ферми. С ростом |t'| область сверхпроводимости *d*-симметрии остается достаточно широкой и смещается в область меньшего допирования. Одновременно с ростом |t'| происходит уменьшение максимальной температуры перехода. Сдвиг области сверхпроводимости в сторону меньшего допирования и убывание T_c при t' < 0 требуют объяснения. Простейшая гипотеза состоит в предположении возможного сокращения области «двумерного» антиферромагнетизма и, как следствие, сдвига области сверхпроводимости. Однако эта гипотеза не проходит: область антиферромагнитного порядка практически не меняется при изменении t' в пределах ($-0.1 \div 0.1$). Это видно из рис. 9, где приведены результаты для чередующейся спиновой плотности d_0 самосогласованных решений AF + VB. Поэтому опять обратимся к деталям хаббардовских зон и поверхности Ферми.

При t' < 0 энергия $E_1(k)$ в наиболее плоских участках $k \sim (\pi, 0)$ нижней хаббардовской зоны не пересекает, а лишь приближается к уровню Ферми μ (см. рис. 10). Увеличение наклона кривых $\partial E_1(k, \delta)/\partial \delta|_{k=(\pi,0)}$ с увеличением |t'| при t' < 0 отвечает уменьшению эффективной плотности состояний и величины T_c . Из того же рис. 10 следует, что при t' < 0 и некотором допировании $\delta^* = \delta^*(t')$ имеет место пересечение уровня Ферми и зонной энергии в точке $k = (\pi/2, \pi/2)$. Но области вблизи $k \sim (\pi/2, \pi/2)$ не участвуют в создании сверхпроводящего порядка $d_{x^2-y^2}$ -симметрии, так как на линиях $k_x = \pm k_y$ щель равна нулю. Поэтому значение δ^* , при котором $E_1(k) - \mu = 0$ в точке



Рис. 9

Рис. 10

Рис. 9. Зависимость величины чередующейся спиновой плотности d_0 от допирования для U/t = 4, 6, 8, V = 0 и t' = 0 (сплошные кривые). Штриховая кривая и точки соответствуют U/t = 8, V/t = 0.1 и t'/t = 0.1 и -0.1

Рис. 10. То же, что на рис. 8, но для $t' \le 0$: кривые 1, 4, 5 соответствуют значениям t'/t = 0, -0.05, -0.1 и фазовым кривым 1, 4, 5 на рис. 7

 $k = (\pi/2, \pi/2)$, никак не соотносится с максимумом T_c при t' < 0. При отрицательном t' качественно другой характер имеет и поверхность Ферми. При малом допировании, $\delta < \delta^*$, обобщенная граница Ферми состоит из диэлектрических участков границы магнитной зоны Бриллюэна в областях $k \sim (\pi/2, \pi/2)$ и металических участков «малой» поверхности Ферми вокруг точек $(\pi, 0)$. Обсуждаемые результаты относятся к состоянию с определенной структурой валентных связей, а именно, с образованием валентных связей соседних узлов, которое индуцирует сверхпроводимость $d_{x^2-y^2}$ -симметрии. При t' > 0 такая картина дает разумное объяснение фазовой кривой $T_c(\delta)$ и явления анизотропной псевдощели. Однако в случае t' < 0 предсказания расчета и наблюдаемой фазовой диаграммы расходятся, хотя этот случай, похоже, реализуется в системе La_{2-x}Sr_xCuO₄. На последнее указывает интерпретация особенностей неупругого нейтронного рассеяния при $\omega \rightarrow 0$ [40, 41]. Расхождение фазовых кривых для t' < 0 ставит вопрос: возможно ли образование других структур валентных связей и (или) возможна ли другая симметрия сверхпроводящего спаривания.

4. ВЫВОДЫ

В заключение отметим следующее.

1. Унитарное преобразование, отвечающее учету корреляций типа валентных связей, позволяет получить модельный гамильтониан, в котором прыжки модулируются заселенностями центров, аналогично модели Хирша [22]. Именно такая модуляция прыжков обеспечивает притяжение дырок в d-канале, но в отличие от [22] параметры взаимодействия определяются вариационно. В отличие от t - J-модели с запретом двукратного заселения узлов полученный эффективный гамильтониан можно обрабатывать в приближении среднего поля.

2. Выигрыш энергии при малом допировании обеспечивают удвоение решетки через спиновые чередования, а также образование валентных связей соседних узлов. Открытыми остаются вопросы о происхождении небольшого отличия энергии от результатов, полученных для конечных систем, и об эффективности других возможных типов корреляций, не включенных в наше рассмотрение.

3. Механизм притяжения дырок вследствие модуляции прыжков заселенностями центров при образовании валентных связей не сводится к обмену антиферромагнитными флуктуациями, широко обсуждаемыми [42, 43] в качестве причины притяжения. Эффективные константы притяжения определены из вариационного расчета и оказываются близки как для антиферромагнитного, так и для парамагнитного состояний валентных связей. Вместе с тем оказывается, что только при антиферромагнитном расщеплении исходной зоны плотность уровней на границе Ферми достаточно высока, чтобы приводить к заметной величине сверхпроводящей щели и температуры перехода $2\Delta(0) \approx 4.5$, $kT_c \leq 0.023t$ при $U/t \leq 8$.

4. Для классической модели Хаббарда H(U, t) сверхпроводящий порядок $d_{x^2-y^2}$ -симметрии проявляется в широкой области допирования, которая простирается вплоть до $n \to 1$ и лежит внутри области «двумерного» (или скрытого) антиферромагнетизма. Это противоречит фазовой диаграмме реальных купратов.

5. Расчеты, проведенные для обобщенной модели Хаббарда, показали очень высокую чувствительность фазовой кривой $T_c(\delta)$ и поверхности Ферми к величине и знаку прыжкового взаимодействия t' неближайших соседей. При t' > 0 установлено совпадение оптимального уровня допирования δ_{opt} с тем допированием, при котором энергия наиболее плоских участков нижней хаббардовской зоны при $k \sim (\pi, 0)$ пересекает уровень Ферми. При этом анизотропная псевдощель нормального состояния недодопированных образцов должна ассоциироваться с энергией $|E(\pi, 0) - \mu|$ погружения нижней зоны в области $k \sim (\pi, 0)$ относительно уровня Ферми.

Выполнение работы оказалось возможным благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 7-03-33727А и 96-15-97492). Авторы благодарны также В. Я. Кривнову за полезные обсуждения и Р. О. Зайцеву за конструктивные и полезные замечания.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оператор $H^{(2)}$ при $\alpha^2/2$ в эффективном гамильтониане (6) равен

$$H^{(2)} = H_U^{(2)} + T^{(2)}, (32)$$

$$H_{U}^{(2)} = -U \sum_{\langle nm \rangle} \left\{ R(n,m) + \sum_{m_{i}} Q(n,m,m_{i}) + \sum_{n_{i}} Q(m,n,n_{i}) \right\}.$$
 (33)

В последних трехузельных членах суммирование ведется по $m_i \in \langle mm_i \rangle$, $m_i \neq n$ и $n_i \in \langle nn_i \rangle$, $n_i \neq m$, а операторы R и Q равны

$$R(n,m) = \Delta_{nm\uparrow} \Delta_{nm\downarrow} + j_{nm\uparrow} j_{nm\downarrow}, \qquad (34)$$

$$Q(n,m,m_i) = -\frac{1}{4} \sum_{\sigma} \{ t_{nm_i\sigma} \Delta_{nm,-\sigma}^2 \Delta_{mm_i,-\sigma} + (c_{n\sigma}^{\dagger} c_{m\sigma} c_{m,-\sigma}^{\dagger} c_{m_i,-\sigma} + \text{H.c.}) - t_{nm\sigma} t_{mm_i,-\sigma} (n_{n,-\sigma} + n_{m_i\sigma} - 2n_{n,-\sigma} n_{m_i\sigma}) \},$$
(35)

$$T^{(2)} = -t \sum_{\sigma, \langle nn' \rangle} \{ [2c_{n\sigma}^{\dagger(1)} c_{n'\sigma}^{(1)} + c_{n\sigma}^{\dagger(2)} c_{n'\sigma} + c_{n\sigma}^{\dagger} c_{n'\sigma}^{(2)}] + \text{H.c.} \},$$
(36)

$$c_{n\sigma}^{(1)} = -\frac{1}{2} \sum_{m \in \langle nm \rangle} (c_{n\sigma} j_{nm,-\sigma} + c_{m\sigma} \Delta_{nm,-\sigma}), \tag{37}$$

$$c_{n\sigma}^{(2)} = \sum_{m \in \langle nm \rangle} \{ L(n,m) + \sum_{m_i} M(n,m,m_i) + \sum_{n_i} N(n,m,n_i) \}.$$
(38)

В трехузельных вкладах суммирование ведется соответственно по $m_i \in \langle mm_i \rangle$, $m_i \neq n$ и $n_i \in \langle nn_i \rangle$, $n_i \neq m$, а операторы в (38) равны

$$L(n,m) = -\frac{1}{2} [c_{m\sigma}(1-2n_{n\sigma})t_{nm-\sigma} + c_{n\sigma}\Delta_{nm-\sigma}^{2}],$$

$$M(n,m,m_{i}) = \frac{1}{4} [c_{n\sigma}j_{mm_{i}\sigma}t_{nm-\sigma} + c_{m_{i}\sigma}\Delta_{nm-\sigma}\Delta_{nm_{i}-\sigma} + c_{n\sigma}\Delta_{mm_{i}\sigma}j_{nm_{i}-\sigma} + c_{m\sigma}\Delta_{nm-\sigma}j_{mm_{i}-\sigma} + c_{m\sigma}n_{m_{i}\sigma}t_{mm_{i}-\sigma}],$$
(39)

$$N(n, m, n_i) = \frac{1}{4} [c_{n_i\sigma} j_{nm-\sigma} \Delta_{nn_i-\sigma} + c_{n_i\sigma} n_{n\sigma} t_{nm-\sigma} + c_{n\sigma} j_{nm-\sigma} j_{nn_i-\sigma} + c_{n\sigma} n_{n_i\sigma} j_{mn_i-\sigma} + c_{m\sigma} \Delta_{nn_i\sigma} t_{nn_i-\sigma}].$$
(40)

Операторы $j_{nm\sigma}, \Delta_{nm\sigma}, t_{nm\sigma}$ определены формулами (4), (11).

Вычисление средних от (33) и (36) в расчете на 1 узел решетки дает

$$\langle H^{(2)} \rangle = [\mathscr{H}_U^{(2)} + \mathscr{T}^{(2)}]|_{w=0} + \sum_{ij} k_{ij}^{(2)} w_i w_j, \qquad (41)$$

$$\mathcal{H}_{U}^{(2)} = 4U \left\{ 2d_{0}^{2} + 3r_{1}^{2} [(1 - 2r_{0})^{2} - 4d_{0}^{2}] + (\overline{r_{\nu}} - 2\overline{\phi_{\nu 0}})[r_{0}(1 - r_{0}) + d_{0}^{2} + 6r_{1}^{2}] + [\overline{d_{\nu}}d_{0} + 8r_{1}^{2}\overline{\phi_{\nu}} + \overline{r_{\nu}}\phi_{\nu} - 2\overline{\phi_{\nu}}\phi_{\nu 0}] \right\},$$

$$(42)$$

$$\phi_0 = r_0^2 - d_0^2 - r_1^2, \qquad \phi_l = r_l^2 - d_l^2, \qquad \phi_{0l} = r_0 r_l - d_0 d_l, \\ f_0 = r_0^2 + d_0^2, \qquad f_l = r_l^2 + d_l^2, \qquad \phi_{l,l'} = r_l r_{l'} - d_l d_{l'}.$$

$$(43)$$

Любая из величин $\overline{A_{\nu}} = \{\overline{r_{\nu}}, \ \overline{d_{\nu}}, \ \overline{\phi_{\nu}}, \ \overline{\phi_{0\nu}}, \ \overline{f_{\nu}}, \ \overline{r_{\nu}\phi_{\nu}}, \ \overline{\phi_{\nu}\phi_{\nu 0}}\}$ означает

$$\overline{A_{\nu}} = 2A_{\sqrt{2}} + A_2$$

С учетом этих обозначений получаем

$$\mathcal{T}^{(2)} = -4t \left\{ r_1 \left[-51r_0(1-r_0) - 93(d_0^2 + 2r_1^2) - 18(\overline{r_\nu} - 2\overline{\phi_{0\nu}}) + 5\overline{f_\nu} + 6f_{\sqrt{2}} + 2(4\phi_{\sqrt{2}} + 4\phi_{2,\sqrt{2}} + \phi_2) + 6(\overline{r_\nu})^2 + 2(\overline{d_\nu})^2 - 8d_0\overline{d_\nu} \right] + (r_3 + 6r_{\sqrt{5}}) \left[-r_0(1-r_0) - 7d_0^2 - 10r_1^2 \right] + 6r_{\sqrt{5}}\overline{f_\nu} + 3r_3f_2 \right\}.$$
(44)

Вклад в среднюю энергию (16) от аномальных параметров порядка, вычисленный в квадратичном по w_l приближении, в расчете на один узел решетки равен

$$\overline{\mathscr{H}}^{SC} = [-8\alpha U r_1] w_1^2 + \alpha^2 [S_U + S_T],$$
(45)

$$S_{U} = U \left\{ 4w_{1}^{2} [2r_{0}(1-r_{0}) + \overline{r_{\nu}}(1-2r_{0}) + 2d_{0}\overline{d_{\nu}} + 4d_{\sqrt{2}}^{2} - 2d_{2}^{2}] + 8w_{1}w_{2}[r_{1}(1-2r_{0})] + 2w_{2}^{2}[r_{2}(1-2r_{0}) + 8r_{1}^{2} - 2d_{0}d_{2}] \right\},$$
(46)

$$S_T = -2t \left\{ w_1^2 [-34r_1 - 18r_{\sqrt{5}} - 3r_3] + w_2^2 [r_1 + 8r_{\sqrt{5}} + 3r_3] + w_{\sqrt{5}}^2 [-6r_{\sqrt{5}}] + w_3^2 [-r_3] + w_1 w_5 [4r_1] + w_1 w_3 [2r_1] \right\}.$$
(47)

Матрица $D_{i,j} = \partial w_i / \partial w_j$ при $w_l = 0$ в уравнении (30) находится с использованием решений AF + VB и равна

 $D_{ij} = B_{i\nu} k_{\nu j},$

где $k_{\nu j}$ — коэффициенты квадратичной формы $\mathcal{H}^{SC} = k_{\nu j} w_{\nu} w_{j}$ от аномальных средних в (18), а элементы матрицы B_{ij} выражаются через энергии $E_{1(2)}(k)$ верхней и нижней хаббардовских зон с антиферромагнитной щелью $2\Delta_k$ между ними

$$B_{\nu j} = -N^{-1} \sum_{k}^{F} R(l_{\nu}, l_{j}, k), \quad l_{j} = \{1, 2, \sqrt{5}, 3\}_{j},$$
(48)

$$R(l, l', k) = q_l q_{l'} \left(\frac{1 - 2f_1}{2E_1} + \frac{1 - 2f_2}{2E_2} \right), \quad l, l' \neq 2,$$

$$R(2,2,k) = q_2^2 \left[\cos^2 \gamma_k \left(\frac{1-2f_1}{2E_1} + \frac{1-2f_2}{2E_2} \right) + \sin^2 \gamma_k 2 \frac{1-f_1-f_2}{E_1+E_2} \right],$$
(49)

$$R(2,l,k) = R(l,2,k) = q_l q_2 \cos \gamma_k \left(\frac{1-2f_1}{2E_1} - \frac{1-2f_2}{2E_2}\right), \quad l \neq 2.$$

Здесь $f_{1(2)}$ — фермиевские функции для энергий зон (отсчитанных от химического потенциала)

$$E_{1(2)}(k) = (\epsilon_k + \epsilon_{\bar{k}})/2 \mp \sqrt{(\epsilon_k - \epsilon_{\bar{k}})^2/4 + \Delta_k^2} - \mu,$$
(50)

величины γ_k , ϵ_k , и Δ_k определяются соответственно уравнением tg $\gamma_k = (\epsilon_k - \epsilon_k)/\Delta_k$ и выражениями (26). В отсутствие антиферромагнетизма и при одном аномальном параметре порядка уравнение для T_c принимает стандартный БКШ-вид, кроме дополнительного весового множителя $q_1^2(k)$ под суммами по k, соответствующего *d*-симметрии сверхпроводящего порядка. В этом случае два вклада от E_1 и E_2 с суммированием по k в половинной зоне Бриллюэна эквивалентны результату суммирования по всей зоне Бриллюэна для единой нерасщепленной зоны. В электронно- или дырочнодопированной системе в случае антиферромагнитного расщепления зоны лишь одна из подзон E_1 или E_2 реально определяет детерминант (30) и T_c .

Ввиду малости сверхпроводящей щели в сравнении с шириной зоны и антиферромагнитным расщеплением при решении полной задачи AF + VB + SC можно без потери точности использовать приближенные выражения для собственных энергий \mathscr{F}_{λ} и собственных функций (28) линеаризованного гамильтониана (24). Они определяются приближенным решением уравнения (28):

$$\boldsymbol{\mathscr{C}}_{\lambda} = \{\boldsymbol{\mathscr{C}}_1, \boldsymbol{\mathscr{C}}_2, -\boldsymbol{\mathscr{C}}_1, -\boldsymbol{\mathscr{C}}_2\}_{\lambda},\tag{51}$$

$$\mathscr{F}_{i} = -\sqrt{(E_{i} - \mu)^{2} + W_{i}^{2}}, \quad i = 1, 2,$$

$$S_{i\lambda}(k) = \begin{pmatrix} c_{\varphi} & s_{\varphi} & 0 & 0\\ -s_{\varphi} & c_{\varphi} & 0 & 0\\ 0 & 0 & c_{\varphi} & -s_{\varphi}\\ 0 & 0 & s_{\varphi} & c_{\varphi} \end{pmatrix}_{ij} \begin{pmatrix} c_{1} & 0 & -s_{1} & 0\\ 0 & c_{2} & 0 & -s_{2}\\ s_{1} & 0 & c_{1} & 0\\ 0 & s_{2} & 0 & c_{2} \end{pmatrix}_{j\lambda}.$$
(52)

Здесь

$$s_{\varphi} = \sin \varphi, \quad c_{\varphi} = \cos \varphi, \quad c_i = \cos \theta_i, \quad s_i = \sin \theta_i$$

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2\Delta_k}{\epsilon_k - \epsilon_{\tilde{k}}}, \quad \operatorname{tg} 2\theta_i = \frac{2W_i}{E_i - \mu}, \quad i = 1, 2,$$
$$W_{1(2)} = \frac{1}{2} [W_k + W_{\tilde{k}} + \cos 2\varphi (W_k - W_{\tilde{k}})].$$

Величины ϵ_k , Δ_k , W_k , $E_{1(2)}$ определены уравнениями (26), (50).

Литература

- 1. Z.-X. Shen and D. S. Dessau, Phys. Rep. 253, 1 (1995).
- 2. J. W. Allen, R. Claessen, R. O. Anderson et al., in *The Physics of the Hubbard model*, ed. by D. K. Campbel, J.M.P. Carmelo and F. Guinea, Plenum Press, New York (1994).
- 3. T. E. Mason, G. Aeppli, S. M. Hayden et al., Phys. Rev. Lett. 71, 919 (1993).
- 4. J. R. Kirtley, C. C. Tsuei, J. Z. Sun et al., Nature 373, 225 (1995).

- 5. D. A. Brawner, C. Mancer, and H. R. Ott, Phys. Rev. 55, 2788 (1997).
- 6. D. S. Marshall, D. S. Dessau, A. G. Loeser et al., Phys. Rev. Lett. 76, 4841 (1996).
- 7. A. G. Loeser, Z.-X. Shen, D. S. Dessau et al., Science 273, 325 (1996).
- 8. H. Ding, T. Yokoya, J. C. Campuzano et al., Nature 382, 51 (1996).
- 9. E. Dagotto, Rev. Mod. Phys. 66, 763 (1994).
- 10. D. J. Scalapino, Phys. Rep. 250, 329 (1995).
- 11. E. Dagotto and T. M. Rice, Science 271, 618 (1996).
- 12. Ю. А. Изюмов, УФН 167, 465 (1997).
- Р. О. Зайцев, Письма ЖЭТФ 55, 141 (1992); 56, 355 (1992).
- 14. J. H. Jefferson, H. Eskes, and L. F. Feiner, Phys. Rev. B 45, 7959 (1992).
- 15. H. B. Schuttler and A. J. Fedro, Phys. Rev. B 45, 7588 (1992).
- 16. P. W. Anderson, Science 235, 1196 (1987).
- 17. E. J. Mele, Phys. Rev. B 38, 8940 (1988).
- 18. I. I. Ukrainskii, Int. J. Quant. Chem. 52, 413 (1994).
- 19. А. А. Овчинников, М. Я. Овчинникова, ЖЭТФ 110, 342 (1996).
- 20. А. А. Овчинников, М. Я. Овчинникова, ЖЭТФ 112, 1409 (1997).
- 21. M. C. Gutzwiller, Phys. Rev. A 137, 1726 (1965).
- 22. J. E. Hirsch, Phys. Rev. Lett. 54, 1317 (1985).
- 23. E. Dagotto, A. Moreo, F. Ortolani et al., Phys. Rev. B 67, 10741 (1992).
- 24. R. J. Radke and M. R. Norman, Phys. Rev. B 50, 9554 (1994).
- 25. M. S. Hybertsen, E. B. Stechel, M. Schluter, and D. R. Jennison, Phys. Rev. B 41, 11068 (1990).
- 26. D. Duffy and A. Moreo, Phys. Rev. B 52, 15607 (1995).
- 27. U. Trapper, D. Ihle, and H. Fenke, Phys. Rev. B 52, R11553 (1995).
- 28. G. Baumgartel, J. Schmalian, and K. H. Benemann, Europhys. Lett. 24, 601 (1993).
- Г. М. Элиашберг, в кн. Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников, под ред. Д. М. Гинзберг, Мир, Москва (1990).
- 30. P. Aebi, J. Osterwalder, P. Schaller et al., J. Phys. Chem. Solids 56, 1845 (1995).
- 31. N. Nagaosa, Science 275, 1078 (1997).
- 32. S. C. Zhang, Science 275, 1089 (1997).
- 33. N. E. Brickers and S. R. White, Phys. Rev. B 43, 8044 (1991).
- 34. C.-H. Pao and N. E. Brickers, Phys. Rev. Lett. 72, 1870 (1997).
- 35. P. Monthoux and D. J. Scalapino, Phys. Rev. Lett. 72, 1874 (1997).
- 36. St. Lenck, J. P. Carbotte, and R. C. Dynes, Phys. Rev. B 50, 10149 (1994).
- 37. M. C. Schabel, C. M. Park, A. Matsuura et al., Phys. Rev. 55, 2796 (1997).
- 38. V. J. Emery and S. A. Kivelson, Nature 373, 434 (1995).
- 39. S. Doniach and M. Inui, Phys. Rev. B 41, 6668 (1990).
- 40. P. Benard, L. Chen, and A.-M. S. Tremblay, Phys. Rev. B 47, 589 (1993).
- 41. Q. Si, Y. Zha, K. Levin, and J. P. Lu, Phys. Rev. B 47, 9055 (1993).
- 42. D. Pines, J. Phys. Chem. Solids 56, 1651 (1995).
- 43. P. Montoux and D. Pines, Phys. Rev. B 50, 16015 (1994).